



NEW!



NEW!



Основные характеристики	Принцип работы	Фотоэлектрический датчик			
	Стиль корпуса	Площадь			
	Оптический принцип работы	Подавление фона с диффузным отражением			
	Дальность обнаружения	2~150mm		2 ~ 300 мм (матовая белая бумага)	
	Размер пятна	–	Ø2mm/150m	Ø8mm/300mm	–
	Обнаруженный объект	–			
	Источник света	Красный светодиод 660 нм (модулированный)			
	Индикатор	Индикатор работы: зеленый; Индикатор действия: красный	Иметь	Индикатор работы: зеленый; Индикатор действия: красный	
Электрические данные	Регулировка чувствительности	6-витковый потенциометр			
	Переключение режимов	L.on (световое включение)/D.on (темное включение) переключаемое			
	Режим вывода	Коллектор NPN или PNP открыт			
	Время ответа	≤1ms			
	Частота коммутации	–			
	Повторяемость	–			
	Гистерезис	≤5%	≤5%(Матовая белая книга)	–	
	Рабочее напряжение	10~30V DC			
	Потребление тока	≤25mA		≤20mA	
	Остаточное напряжение	< 1.5V			
	Ток нагрузки	≤100mA			
	Сопротивление изоляции	20MΩ			
	Выдерживаемое напряжение	1000 В переменного тока (50/60 Гц), 1 минута между клеммой питания и корпусом			
	Цепь защиты	Защита от обратной полярности/ Защита от короткого замыкания/защиты от перенапряжения		Защита от обратной полярности/защита от короткого замыкания/ Защита от перенапряжения / Защита от интерференционного света	
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-25°C~+55°C		-10 ~ 70 °C (без замерзания)	
	Температура хранения	-30°C~+70°C		-25 ~ 80 °C (без замерзания)	
	Влажность при эксплуатации	35 ~ 85% относительной влажности (без конденсации)			
	Влажность при хранении	35 ~ 95% относительной влажности (без конденсации)			
	Окружающее освещение	Лампа накаливания ≤ 3000 люкс; Солнечный свет ≤ 10000 люкс			
	Устойчивость к вибрации	10 ~ 50 Гц, амплитуда 0,5 мм, 2 часа по осям X/Y/Z			
Механические данные	Степень защиты	IP67			
	Максимальный момент затяжки	–			
	Способ подключения	–			
	Размеры	31*20*11mm			
	Материал	PBT + стекловолокно (корпус); ПММА (линзы)			
	Вес	0.05kg			
Модель	Принадлежности	Отвёртка	отвертка, кронштейн, Винты и гайки	Отвёртка	
	NPN	ESB-BS15N	ESB-BS15AN	ESB-BS30N	ESB-BS30AN
PNP	ESB-BS15P	ESB-BS15AP	ESB-BS30P	ESB-BS30AP	

Оптоволоконный кабель

Щелевые датчики

Фотоэлектрический

Лазер

Близость

Смещение

Магнитный

Контакт

Площадь

Ультразвуковой

Изображение с искусственным интеллектом

Считыватели кодов

Вибрация

Температура

RFID

Защитный замок на двери

Реледавления

Коммуникация

Принадлежности

Руководство

Фотоэлектрический

Цилиндрический

IP69K высокий

Тип защиты

Площадь

Плоский тип

Тонкий тип

БГС

Распознавание цвета/метки

Тип TOF

Отражатели

Отражатели



NEW!



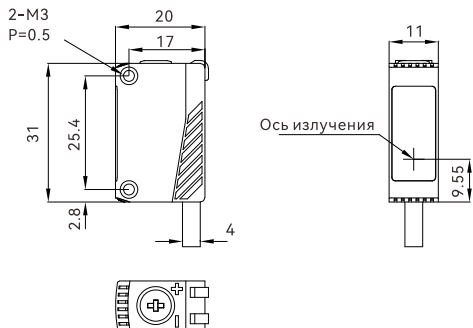
Основные характеристики	Принцип работы	Фотоэлектрический датчик		
	Стиль корпуса	Площадь		
	Оптический принцип работы	Подавление фона с диффузным отражением		
	Дальность обнаружения	1~100mm	1~300mm	
	Размер пятна	65x0.5mm/100mm	Ø8mm/300mm	
	Обнаруженный объект	Ø5 мм (при 50 мм)	≤5mm	
	Источник света	Красный светодиод	Инфракрасный светодиод 940 нм (модулированный)	
	Индикатор	Световой индикатор выхода: оранжевый; Световой индикатор источника света: зеленый		
Регулировка чувствительности	4-оборотный потенциометр	6-витковый потенциометр		
Электрические данные	Переключение режимов	L.on (световое включение)/D.on (темное включение) переключаемое		
	Режим вывода	Коллектор NPN или PNP открыт		
	Время ответа	≤0.3ms	1ms	
	Частота коммутации	≤2000Hz	2kHz	
	Повторяемость	≤5%		
	Рабочее напряжение	10~24V DC	10~30V DC	
	Потребление тока	≤20mA	≤25mA	
	Остаточное напряжение	<1V	≤1.5V	
	Ток нагрузки	100mA	≤100mA(30VDC)	
	Сопротивление изоляции	≥20MΩ(250V DC)	20MΩ	
	Выдерживаемое напряжение	≤0.1mA (1000V AC)		
	Цепь защиты	Защита от обратной полярности/защита от короткого замыкания/ Защита от перенапряжения / Защита от интерференционного света	Защита от обратной полярности/защита от короткого замыкания/защита от перенапряжений	
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-30°C ~ + 70°C (без замерзания)	-25°C ~ +55°C (без замерзания)	
	Температура хранения	-30 ~ 70 °C (без замерзания)	-30°C~+70°C	
	Влажность при эксплуатации	35% ~ 85% относительной влажности (без конденсации)		
	Влажность при хранении	35%~95%RH		
	Окружающее освещение	Лампа накаливания ≤ 5000 люкс; Светодиодная лампа ≤2000 люкс; Солнечный ≤ 20000 люкс	Лампа накаливания ≤ 3000 люкс; Солнечный свет ≤ 10000 люкс	
	Устойчивость к вибрации	10 ~ 50 Гц, амплитуда 1,5 мм, 2 часа по осям X/Y/Z		
Механические данные	Степень защиты	IP66	IP65	
	Максимальный момент затяжки	-		
	Способ подключения	-		
	Размеры	11.0x20.0x31.0mm		
	Материал	Корпус: АБС-пластик со стекловолокном, линза: ПММА	АБС со стекловолокном	
	Вес	0.044kg	0.049kg	
	Принадлежности	Отвёртка		
Модель	NPN	ESB-BL10N	ESB-BV30N	
	PNP	ESB-BL10P	ESB-BV30P	



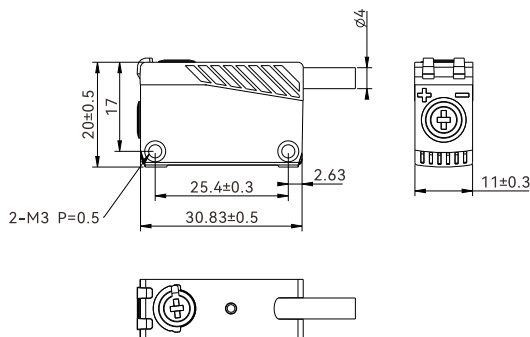
Основные характеристики	Принцип работы	Фотоэлектрический датчик	
	Стиль корпуса	Площадь	
	Оптический принцип работы	Подавление фона с диффузным отражением	
	Дальность обнаружения	Белая бумага: 2 ~ 300 мм	
	Размер пятна	Ø16mm/300mm	
	Обнаруженный объект	-	5mm/0.05m
	Источник света	Красный светодиод 623 нм (модулированный)	Синий светодиод 465 нм (модулированный)
	Индикатор	Индикатор работы: зеленый; Индикатор действия: красный	
	Регулировка чувствительности	6-витковый потенциометр	
Электрические Данные	Переключение режимов	L.on (световое включение)/D.on (темное включение) переключаемое	
	Режим вывода	Коллектор NPN или PNP открыт	
	Время ответа	≤1.5ms	
	Частота коммутации	≤500Hz	
	Повторяемость	≤5%	
	Гистерезис	≤5%	
	Рабочее напряжение	10~30V DC	
	Потребление тока	≤25mA	≤20mA
	Остаточное напряжение	≤1.5V(100mA)	
	Ток нагрузки	≤100mA	
	Сопротивление изоляции	50MΩ	≥50MΩ(500VDC)
	Выдерживаемое напряжение	≤0.1mA (1000V AC)	
	Цепь защиты	Защита от обратной полярности/защита от короткого замыкания/защита от перенапряжения/защита от интерференционного света	
	Условия окружающей среды	Рабочая температура	-25°C ~ +55°C (без замерзания)
Температура хранения		-30°C ~ +70°C (без замерзания)	
Влажность при эксплуатации		35% ~ 85% относительной влажности (без конденсации)	
Влажность при хранении		35% ~ 95% относительной влажности (без конденсации)	
Окружающее освещение		Лампа накаливания ≤ 3000 люкс; Солнечный свет ≤ 10000 люкс	
Устойчивость к вибрации		10 ~ 55 Гц, амплитуда 1,5 мм, 2 часа по осям X/Y/Z	
Степень защиты		IP67	
Механические Данные	Максимальный момент затяжки	-	
	Способ подключения	-	
	Размеры	11.0x31.0x20.0mm	
	Материал	ПБТ + стекловолокно	
	Вес	0.045kg	
	Принадлежности	Отвёртка	
Модель	NPN	ESB-B30N	ESB-BY30N
	PNP	ESB-B30P	ESB-BY30P

- Оптоволоконный кабель
- Щелевые датчики
- Фотоэлектрический**
- Лазер
- Близость
- Смещение
- Магнитный
- Контакт
- Площадь
- Ультразвуковой
- Изображение с искусственным интеллектом
- Считыватели кодов
- Вибрация
- Температура
- RFID
- Защитный замок на двери
- Реледавления
- Коммуникация
- Принадлежности
- Руководство
- Фотоэлектрический
- Цилиндрический
- IP69K высокий
- Тип защиты
- Площадь
- Плоский тип
- Тонкий тип
- BGS**
- Распознавание цвета/метки
- Тип TOF
- Отражатели
- Отражатели

ESB-B30/BL10/BS15/BS30/BV30/BY30N(P)



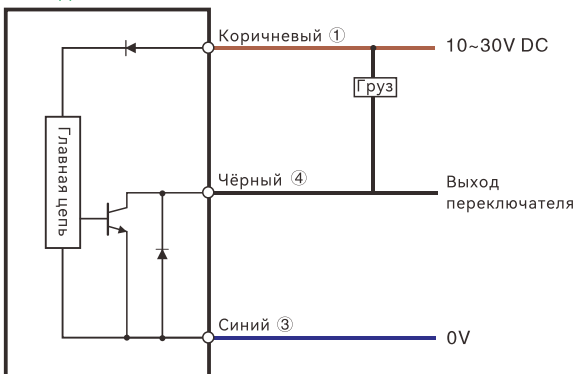
ESB-BS15AN/AP
ESB-BS30AN/AP



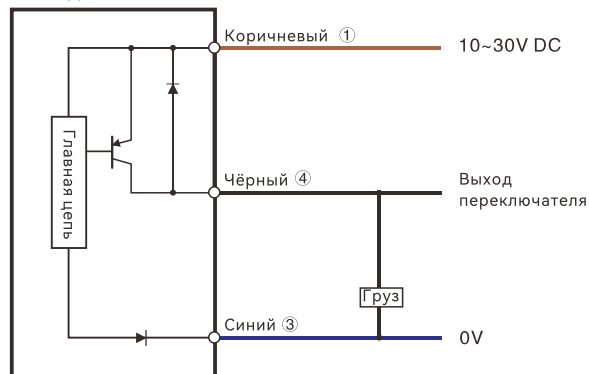
Принципиальная схема

ESB-BS15AN/AP ESB-BS30AN/AP

Выход NPN

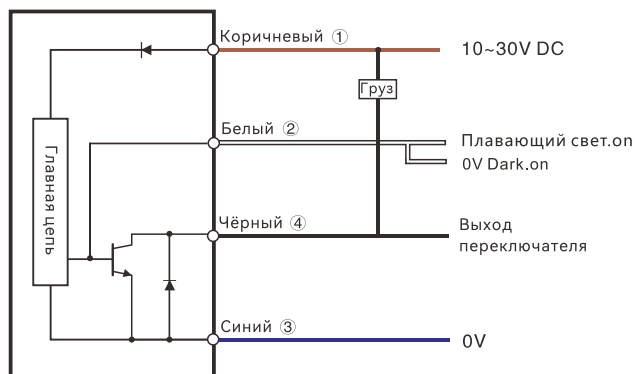


Выход PNP

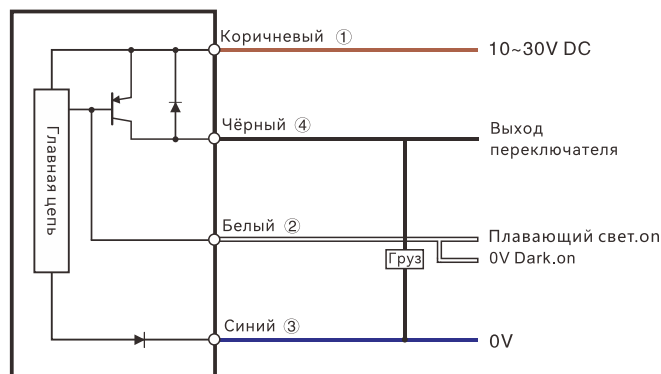


ESB-B30/BL10/BS15/BS30/BV30/BY30N(P)

Выход NPN



Выход PNP



Оптоволоконный кабель
Щелевые датчики
Фотоэлектрический
Лазер
Близость
Смещение
Магнитный
Контакт
Площадь
Ультразвуковой
Изображение с искусственным интеллектом
Считыватели кодов
Вибрация
Температура
RFID
Защитный замок на двери
Реледавления
Коммуникация
Принадлежности
Руководство

Фотоэлектрический
Цилиндрический
Р69К высокий Тип защиты
Площадь
Плоский тип
Тонкий тип
BGS
Распознавание цвета/метки
Тип TOF
Отражатели
Отражатели